

I.ポスター展示リスト【企業】

No.	企業名	担当者氏名
1.	三菱ケミカル株式会社	磯 憲司
2.	ウシオ電機株式会社	深町 俊彦
3.	株式会社イオンテクノセンター	須山 篤志
4.	サムコ株式会社	土橋 篤志
5.	サンケン電気株式会社	八木 修一
6.	株式会社 堀場エステック	佐藤 陽子
7.	レーザーテック株式会社	藤木 翔太
8.	株式会社レーザーシステム	大野 泰夫
9.	株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ	谷出 敦
10.	株式会社シルバコ・ジャパン	大田 一樹

II.ポスター展示リスト【学生】

No.	「タイトル」 発表者（所属）
1.	「HVPE法によるCr ₂ O ₃ テンプレート上へのGa ₂ O ₃ 成長」 武田 栞太 ¹ , 森下 優 ¹ , 肖 世玉 ² , 村上 和仁 ² , 渡邊 守道 ² , 富田 崇弘 ² , 宮川 鈴衣奈 ^{1,3} (1.名古屋工業大学 2.日本ガイシ株式会社 3.核融合科学研究所)
2.	「フェムト秒レーザーによる核融合炉応用のためのタングステン表面加工」 古川 剛 ¹ , 稲垣 達貴 ¹ , 上原 日和 ^{2,3} , 宮川 鈴衣奈 ^{1,2} (1.名古屋工業大学 2.核融合科学研究所 3.総合研究大学院大学)
3.	「Extremely small trap concentrations in quartz-free hydride vapor phase epitaxy-grown n-type GaN confirmed by capacitance transient spectroscopy」 平山 祐輔（名古屋大学 須田研究室）
4.	「Unified explanation of bias dependence of threshold voltage shift under positive bias stress in GaN planer MOSFETs with SiO ₂ gate dielectric」 市川 雄基（名古屋大学 須田研究室）
5.	「Analysis of Acceptor Activation and Lateral Diffusion of Channeled-implanted Mg Atoms in Vertical GaN Junction Barrier Schottky Diodes」 北川 和輝（名古屋大学 須田研究室）
6.	「薄膜ベース p-GaNを用いた AlGaIn/GaN HBTの作製」 丸繁 太一（名古屋大学 天野・本田研究室）
7.	「AlGaInN/GaNヘテロ構造におけるIn組成とAlN中間層が2DEG特性へ与える影響」 脇迫 諒（名古屋大学 天野・本田研究室）
8.	「Design Guideline of Compensation Networks in Capacitive Power Transfer System for Evs」 山中 夕雅（名古屋大学 山本研究室）
9.	「Power Module Design to Reduce Common-Mode Noise」 野崎 凌汰（名古屋大学 山本研究室）